



การวิเคราะห์ตัวอย่าง โดยโกลว์ดิสชาร์จออฟพาร์คอลอ米ส์ชันสเปกโทรมetri (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry, GD-OES)

เรียนเรียงโดย

วันดี สือสายวงศ์

ปัจจุบัน

เทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างในสภาพที่เป็นของแข็งได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ข้อดีของการวิเคราะห์ตัวอย่างของแข็งต่างๆ เช่น โลหะ แก้ว เซรามิก ในสภาพที่ไม่ต้องถูกทำลายคือ

1) สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีและการดัดต่างๆ ในขั้นตอนของการเตรียมตัวอย่างให้อยู่ในสภาพของสารละลายเพื่อการวิเคราะห์โดยเครื่องมือพิเศษ (instrumental analysis) เช่น อะตอมมิคแอน-ชอร์พชันสเปกโทรมetri

2) สามารถลดเวลาที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบ และ

3) ทำให้ปริมาณลักษณะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง

ตัวอย่างของเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบทางเคมีของของแข็ง ตัวอย่างโดยตรง เช่น เอกซ์เรย์ฟลูออเรเซนซ์ (X-ray Fluorescence, XRF) และสปาร์กอิมิสชันสเปกโทรมetri (Spark Emission Spectrometry) นอกจากนี้แล้ว เทคนิคโนโนไซด์้านเครื่องมือได้พัฒนาไปอย่างมาก ทำให้เกิดเทคนิคใหม่ๆ สำหรับการวิเคราะห์ของแข็งเพื่อหาองค์ประกอบทางเคมี

และหาความหนา/ลึก (quantitative depth profiling) อันเนื่องมาจากการเคลือบ ชุบ หรือการสีกกร่อนของผิwtawoyangได้ ตัวอย่างของเทคนิคที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์พื้นผิว (surface analysis) เช่น เทคโนโลยีอ่อนแอมส์เปกโทรมetri (Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS) เอกซ์เรย์ไฟฟ้าอิเล็กตรอนสเปกโทรมetri (X-ray Photoelectron Spectrometry, XPS) และโกลว์ดิสชาร์จสเปกโทรมetri (Glow Discharge Spectrometry, GDS) เป็นต้น

สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงหลักการโดยย่อของโกลว์ดิสชาร์จ และเน้นเฉพาะโกลว์ดิสชาร์จออฟพาร์คอลอ米ส์ชันสเปกโทรมetri (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry) ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถใช้วิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาองค์ประกอบทางเคมีและ/หรือความหนาของ การเคลือบ การชุบ หรือการสีกกร่อนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว เทคนิคนี้สามารถใช้ในการตรวจสอบชาตุส่วนใหญ่ในตารางชาตุทั้งที่เป็นโลหะและไม่เป็นโลหะ หลักการทำงานของเครื่อง

ค่อนข้างง่าย ผู้ปฏิบัติการจึงไม่จำเป็นต้องมีทักษะและความชำนาญสูง นอกจากนี้แล้วค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบำรุงรักษา ก็ค่อนข้างต่ำ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคนี้กับชนิดของตัวอย่างต่างๆ มากมาย ทั้งในการหาองค์ประกอบทางเคมี และการวิเคราะห์พื้นผิวและความหนา/ลึก ซึ่งผลจากการวิจัยดังกล่าวทำให้เทคนิคนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงจรของนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์พื้นผิว ในปัจจุบันโกลว์ดิสชาร์จออฟพาร์คอลอ米ส์ชันสเปกโทรมetri เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงสำหรับการวิเคราะห์พื้นผิว

ประวัติความเป็นมา

โกลว์ดิสชาร์จ (Glow Discharge) หรือเรียกอย่างย่อว่า “GD” ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1852 โดย W.R. Grove ซึ่งรายงานถึงแคโทดิกส์ปัตเตอริง (cathodic sputtering) ในโกลว์ดิสชาร์จเซลล์ ซึ่งเป็นการปลดปล่อยอะตอมของชาตุที่ต้องการวิเคราะห์จากผิวของแคโทด

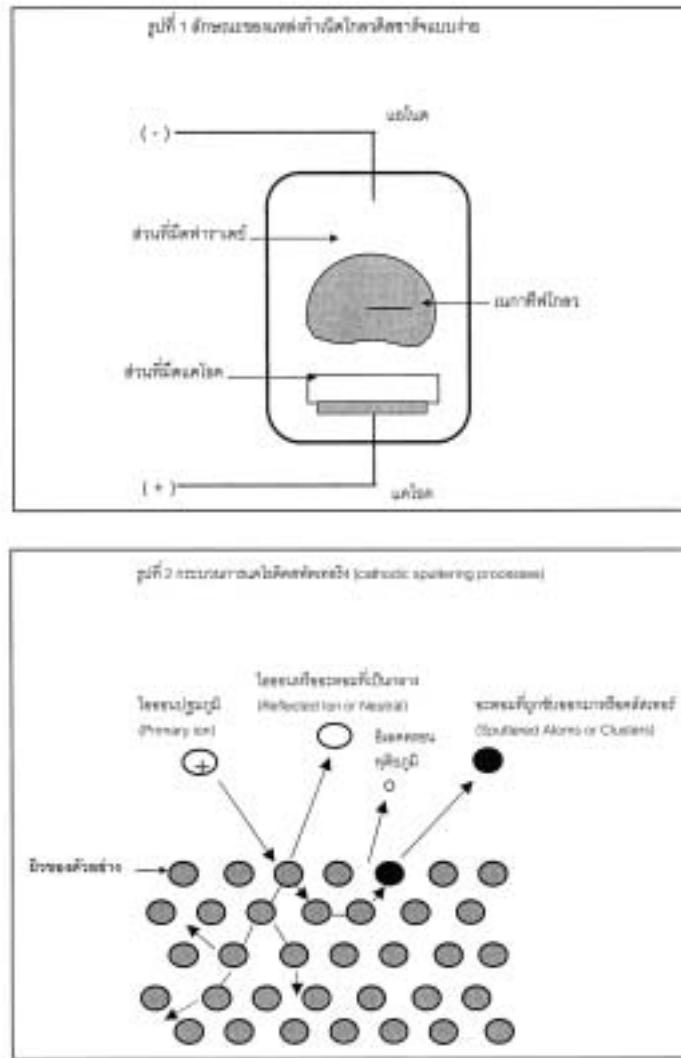


ทำให้มีการคิดออกแบบเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ครั้งใหญ่ หลายทศวรรษ ต่อมาความสนใจในเทคโนโลยีนี้เน้นในด้านฟิสิกส์อะตอม (atomic physics) มากกว่าการวิเคราะห์ทางสเปกโทรเคมี (spectrochemical analysis) อุปกรณ์โกลว์ดิสชาร์จชิ้นแรกที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการวิเคราะห์ทางสเปกโทรเคมีคือแหล่งกำเนิดห้องโลว์แคทโอด (hollow cathode source) ที่ถูกนำมาใช้ในปี ค.ศ. 1947 แหล่งกำเนิดแสงห้องโลว์แคทโอดนั้นบว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญมากในสเปกโทรเคมี (spectrochemistry) โดยเฉพาะสำหรับเทคนิคอะตอมนิกแบบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี (atomic absorption spectrometry, AAS) ต่อมาในปี ค.ศ. 1967 W. Grimm ได้คิดพิมพ์ผลงานของเขาระบบการสร้างแหล่งกำเนิดโกลว์ดิสชาร์จ และนำไปสู่การสร้างเครื่องโกลว์ดิสชาร์จ-ออกพทิกอลิมิสชันสเปกโทรมิเตอร์ เครื่องแรกในปลายปี ค.ศ. 1970 ต่อมาได้มีผู้สนใจศึกษาถึงสมบัติพื้นฐานและความสามารถในการวิเคราะห์ของเทคนิคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์ที่สามารถแสดงผลในรูปของความหนา (depth-profiling analysis) ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจสำหรับนักวิจัยหลายท่านในช่วงต่อมา นักวิจัยทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้รายงานถึงความสามารถของโกลว์ดิสชาร์จในการวิเคราะห์พื้นผิว (surface analysis) เพื่อหาความหนาของการเคลือบหรือการชุมนุมกระพั่งปี ค.ศ. 1978 W. Grimm ได้ร่วมมือกับบริษัท

ผลิตเครื่องโกลดิสชาร์จอพท- คอลอฟิสชันสเปกโตรนิเตอร์เครื่อง แรกเพื่อจำหน่าย เครื่องมือนี้เป็นที่ นิยมสำหรับอุตสาหกรรมโลหะและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโลหะโดยเฉพาะ ในประเทศไทยมี ฝรั่งเศส และ อุปุ่น ปัจจุบันการศึกษาทางทฤษฎี ก็เริ่มกับกระบวนการที่เกิดขึ้นใน โกลดิสชาร์จและการประยุกต์เพื่อ ใช้กับการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ถูก ผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ยังเป็นไป อย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่า เทคนิคนี้มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะ อย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์พื้นผิว หลักการโดยย่อของโกลดิสชาร์จ ความจริงแล้วปรากฏการณ์ ของโกลดิสชาร์จไม่ใช่เรื่องแปลก ใหม่ อย่างที่ทราบกันดีว่าโดยทั่วไป ก้ามมีสมบัติเป็นอนุวนและมีความ เสถียร อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ การแตกตัว (breakdown phenomena) ของก้ามสามารถ พบเห็นได้ในสภาวะที่มีไฟฟ้ากำลัง สูง เช่น ในกรณีของฟ้าผ่า ฟ้าแลบ หรือประกายที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โกลดิสชาร์จที่ความดันต่ำ (low pressure glow discharges) ที่ กำลังกล่าวถึงนี้เป็นลักษณะของ ปรากฏการณ์การแตกตัวที่มีอยู่ใน สถานะที่ก้ามแตกตัวเป็นไออกอน ทำให้สามารถนำไฟฟ้าได้ โกลดิสชาร์จสามารถถูกสร้างอย่างง่ายโดย ใช้หลอดแก้วปลายปิดที่มีข้าไฟฟ้า (electrode) ทั้งสองข้าง เมื่อทำให้ สภาพในหลอดแก้วเป็นสูญญากาศ แล้วปล่อยก้ามเฉือยเช่นอาร์กอนที่ ความดันต่ำระดับมิลลิ托รีไปจนถึง ความดันบรรยายกาศเข้าไป และให้

ความต่างสักยีระหงข้าไฟฟ้าทั้งสองในระดับร้อยโวลต์ไปจนถึง 200-300 กิโลโวลต์ทำให้เกิดพลาสมากายในหลอดแก้วนี้ซึ่งเรียกว่าโกลว์ดิสชาร์จเซลล์ ทำให้หลอดแก้วมีแสงเปล่งออกมากซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “glow”

สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคนี้ โดยทั่วไปใช้ความต่างศักย์ชนิดกระแสตรง (direct current (dc) voltage) เป็นแหล่งให้พลังงาน อย่างไรก็ตามความต่างศักย์ชนิดคลื่นความถี่วิทยุ (radio frequency (rf) voltage) ก็สามารถใช้ได้ดีในการประยุกต์ใช้กับตัวอย่างบางประเภท วิธีที่ง่ายที่สุดในการอธิบายถึงโกลว์ดิสชาร์จสามารถทำได้โดยใช้หลักการพื้นฐานของการปล่อยประจุชนิดกระแสตรง (dc discharge) ก่อน แล้วจึงอธิบายถึงการปล่อยประจุชนิดคลื่นความถี่วิทยุ (rf discharge) ซึ่งใช้หลักการพื้นฐานเช่นเดียวกัน แหล่งกำเนิดโกลว์ดิสชาร์จ (glow discharge source) ชนิดง่ายสำหรับการประยุกต์ใช้ทางการวิเคราะห์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่สำคัญดังแสดงในรูปที่ 1 จากกฎประจำเห็นได้ว่าแหล่งกำเนิดทำหน้าที่เป็นข้อแอโนด และตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ทำหน้าที่เป็นข้อแคโรด เมื่อเกิดดิสชาร์จหรือพลาสม่าขึ้น ในพลาสม่าจะประกอบด้วยส่วนสำคัญสามส่วนคือ ส่วนที่มีดิบบริเวณแคโรด (cathode dark space, CDS) เนกาทีฟโกลว์ (negative glow, NG) และส่วนที่มีดิฟาราเดย์ (Faraday dark space, FDS) เนกาทีฟโกลว์เป็นส่วนที่มีการเปล่งแสงที่สว่างเงินเป็น



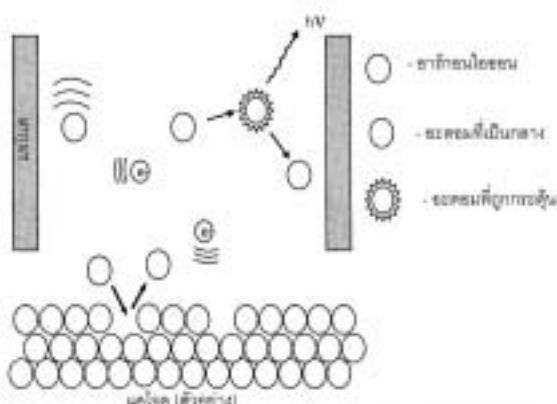
ที่มานของชื่อเทคนิค การเปล่งแสงในช่วงคลื่นที่สามารถมองเห็นได้นี้เป็นผลมาจากการชนกันที่มีการแลกเปลี่ยนพลังงาน กล่าวคือการชนที่มาจากการกระตุ้นในสภาวะกําชและ การแตกตัวเป็นไอออน ในส่วนทึ่หมุดที่ก่อตัวมานี้มีเพียงส่วนที่มีดบริเวณ แคโรด (CDS) และเนก้าทีฟโกลว (NG) ที่ปรากฏอยู่ระหว่างขั้วทั้งสองในอุปกรณ์ทางการวิเคราะห์ของโกลวิดิษาร์จ (analytical GD devices) เพราะส่วนทึ่สองในโกลวิดิษาร์จพลาสมามีส่วนที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์

เมื่อให้ความต่างศักย์ที่เป็นลบที่ขั้วแคโรด (ตัวอย่าง) จะเกิดประกายการณ์ที่ทำให้อิเล็กตรอนถูกส่งออกมาจากแคโรดโดยการเปล่งรังสีทุกทิศทาง (omnipresent cosmic radiation) ด้วยความเร็วสูง เพื่อเคลื่อนที่ผ่านพลาสม่าไปยังอีกขั้วหนึ่งที่มีความต่างศักย์เป็นบวก ระหว่างการเคลื่อนที่ผ่านพลาสม่า อิเล็กตรอนเหล่านี้จะชนกับอาร์กอนไอออนที่เป็นบวกที่เกิดจากอาร์กอนอะตอม ไอออนบวกของอาร์กอนเหล่านี้จะถูกดึงดูดโดยขั้วที่เป็นลบที่ซึ่งมันจะเข้าชนด้วยพลังงานที่มากพอที่จะทำให้อะตอมที่ผิวของแคโรด

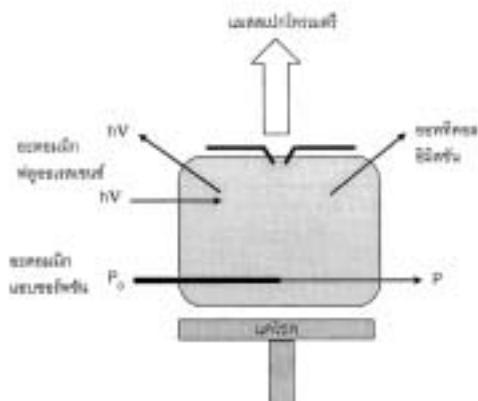
หลุดออกจากตัวอย่างในรูปที่ 2 กระบวนการนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อของแคโรดิคสปัตเตอริง (cathodic sputtering processes) ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดอะตอม (atomization) ในโกลวิดิษาร์จ เมื่ออะตอมที่ถูกขับออกจากผิวของแคโรดเคลื่อนที่เข้าไปยังส่วนของพลาสม่า มันจะถูกกระตุ้นโดยการชนกับอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงกว่าหรือชนกับอาร์กอนอะตอมกึ่งเสถียร (metastable argon atoms) ที่ถูกกระตุ้นแล้ว จากนั้นอะตอมที่ถูกกระตุ้นเหล่านี้จะกลับลงสู่สภาวะปกติโดยการเปล่งแสงที่มองเห็นได้ (optical emission) ดังแสดงในรูปที่ 3 กระบวนการนี้คือที่มาของชื่อเฉพาะ “โกลวิดิษาร์จ” การเปล่งแสงของอะตอมที่ถูกกระตุ้นเพื่อกลับลงสู่สภาวะปกติเป็นสมบัติเฉพาะตัวตามความยาวคลื่นของแต่ละชาติ โดยการคำนวณสัญญาณที่ความยาวคลื่นเหล่านั้น เราสามารถคำนวณจำนวนของอะตอมแต่ละประเภทที่มาจากการกระตุ้นจากกระบวนการที่ทำให้เกิดการกระตุ้น ยังมีการชนกันที่ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอ้อน (ionization collisions) ทำให้มีคู่ของไอ้อนกับอิเล็กตรอน (ion-electron pairs) กระบวนการนี้เกิดเนื่องจากไอ้อนถูกเร่งด้วยความเร็วจากแคโรด (ดูรูปที่ 2) ที่ซึ่งมันปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electrons) อิเล็กตรอนเหล่านี้จะถูกเร่งด้วยความเร็วจากแคโรดเช่นกัน และสามารถทำให้เกิดการชนกันที่ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอ้อนมากขึ้น กระบวนการ



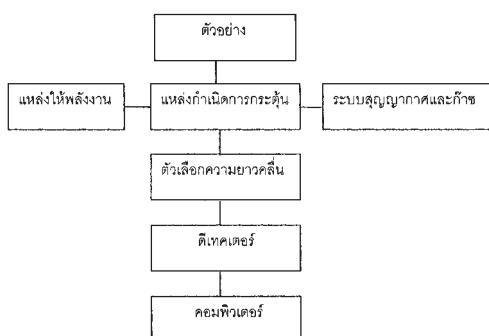
รูปที่ 3 กระบวนการเสียบและกำกับ (Spattering and excitation processes)



รูปที่ 4 รูปแบบการเสียบและการกำกับ



รูปที่ 5 ส่วนประกอบของโกลวิดิชาร์จอพทิคอลอมิสชัน



เปล่งแสงของอิเล็กตรอนทุติกวนที่
แคริโอดและการแตกตัวเป็นไออกอน
ในกําชันนี้ทำให้พลาสมารสามารถคง

อยู่ได้ (self-sustained plasma)

รูปแบบของการวิเคราะห์
สามารถทำได้โดยอาศัยแหล่งกำเนิด

โกลวิดิชาร์จ แสดงในรูปที่ 4
เนื่องจากสปีชีส์ (species) ส่วน
ใหญ่ที่ถูกขับออกมาจากผิวด้วย
โดยโกลวิดิชาร์จพลาasma เป็น
อะตอมที่มีสภาพที่เป็นกลาง (ground
state neutrals) ชาตุเหล่านี้สามารถ
วิเคราะห์โดยอะตอมมิกแบบชอร์ฟ-
ชันสเปกโโทรเมตรี ถ้าชาตุที่ต้องการ
วิเคราะห์ถูกกระตุ้นโดยแหล่งกำเนิด
ไฟฟ่อนายนอก ชาตุเหล่านี้สามารถ
วิเคราะห์โดยอะตอมมิกฟลูออเรสเซนซ์
สเปกโโทรเมตรี เมื่อสปีชีส์ที่ถูกทำให้
ออกมากจากผิวด้วยเคลื่อนที่เข้าไป
ในส่วนของเนกานทีฟโกลว์ มันจะ
ผ่านกระบวนการกรองในแบบต่างๆ
ทำให้สปีชีส์ถูกกระตุ้น (excited
species) เกิดการเปล่งแสงของ
ไฟฟ่อนที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
แต่ละชาตุขึ้น ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ได้โดยใช้อพทิคอลอมิสชันสเปก
โโทรเมตรี สำหรับสปีชีส์ที่ผ่าน
กระบวนการกรองที่มีพลังงานมากจะ
ทำให้เกิดเป็นไออกอนซึ่งสามารถ
ตรวจวัดได้โดยแบบสเปกโโทรเมตรี

โกลวิดิชาร์จอพทิคอลอมิสชัน- สเปกโโทรนิเตอร์

โดยทั่วไปโกลวิดิชาร์จอพ-
ทิคอลอมิสชันสเปกโโทรนิเตอร์
ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดโกลวิดิช-
าร์จอพทิคอลอมิสชันสเปก-
โโทรนิเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโฟโตน็อกติ-
ไฟเออร์ (photomultipliers) ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการอ่านสัญญาณ
และคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล
และบันทึกข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 5
เนื่องจากโกลวิดิชาร์จเป็นพลาasma
ที่ความดันต่ำจึงเป็นต้องมีปั๊ม
สัญญาณเพื่อทำให้ได้ความดัน

ตามที่ต้องการและเพื่อนำก้าชที่ปล่อยเข้าไป (ที่ใช้กันทั่วไปคือ อาร์กอนที่ความดัน 2-10 托ร์) ออกจากดิสชาร์จเซลล์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ธาตุในช่วงความยาวคลื่น vacuum และ far-vacuum ultraviolet (ต่ำกว่า 200 นาโนเมตร) ควรมีเซอร์โคลนียมเก็ตเตอร์ (Zr getter) เพื่อควบคุมปริมาณของออกซิเจนที่อาจมีอยู่ในท่อ ก้าช

ตามที่กล่าวมาแล้วว่า การทำให้เกิดดิสชาร์จอาจทำได้โดยการให้ความต่างศักย์ชนิดกระแสตรงหรือความถี่คลื่นวิทยุ (dc or rf potential) การใช้ระบบ pulsed mode ที่สามารถใช้ได้ เช่นกัน เนื่องจากการใช้ความต่างศักย์ชนิดกระแสตรง มีข้อจำกัดสำหรับตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้าจากบัญหาการสะสมของกระแสสูตร (net current flow) การวิเคราะห์ตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้า จึงต้องมีการใช้ตัวช่วยยึดและทำให้ตัวอย่างสามารถนำไฟฟ้าได้ เช่น พองทองแดง หรือผงกราไฟต์ ต่อมาก็มีการใช้ความต่างศักย์ชนิดความถี่คลื่นวิทยุซึ่งมีข้อดีเหนือกว่าการใช้ความต่างศักย์ชนิดกระแสตรงคือ ทำให้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้า เช่น แก้ว เซรามิก ได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้การประยุกต์เทคนิคนี้สามารถขยายขอบเขตไปยังตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องใช้สารช่วยให้นำไฟฟ้าดังเช่นในกรณีของการใช้ความต่างศักย์ชนิดกระแสตรงอย่างไรก็ตาม การใช้ความต่างศักย์แบบความถี่คลื่นวิทยุจำเป็นต้องมีการออกแบบของระบบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ การสูญเสียพลังงานและการรบกวน

จากระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อจะต้องถูกขับออกจากตัวอย่างและผ่านกระบวนการการชนต่างๆ จนเกิดการเปล่งแสงที่เป็นสัญญาณโดยสัญญาณเหล่านี้จะออกจากแหล่งกำเนิดหรือโกลวดิสชาร์จเซลล์ผ่านหน้าต่างและถูกแยกโดยเกรตติงเป็นความยาวคลื่นที่แตกต่างกันตามธาตุที่ถูกวิเคราะห์ แสงที่ถูกแยกแล้วนี้สามารถถูกวิเคราะห์ตามลำดับโดยโนโบรามาเตอร์ (monochromator) หรือวิเคราะห์หลายธาตุในขณะเดียวกันด้วยโพลีโครามาเตอร์ (polychromator) ในโนโบรามาเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปคือ Czerny-turner ซึ่งมีความสามารถในการแยกและส放过ไวในการตรวจวัดสูง สำหรับโพลีโครามาเตอร์ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถตรวจวัดธาตุหลายๆ ธาตุพร้อมกันนักเป็นโพลีโครามาเตอร์ที่รู้จักกันในชื่อของ Paschen Runge mount (หรือ Rowland circle polychromator) และ flat field (หรือ Echelle gratings) ในปัจจุบันมีการใช้ flat field มากขึ้นเนื่องจากการพัฒนาของตัวตรวจวัดแบบโซลิดสเตท (solid state detectors) เช่น charge injection devices (CID), charge coupled devices (CCD) และ photodiode arrays (PDA) อย่างไรก็ได้ ตัวตรวจวัดกึ่งตัวนำไฟฟ้าเหล่านี้มีการตอบรับต่อสัญญาณที่ชา นี dark current สูง และความสามารถในการแยกที่ต่ำกว่าการใช้หลอดไฟโคมัลติไฟเออร์

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis)

1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อหาองค์ประกอบทางเคมี (Bulk analysis)

การวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบทางเคมีโดยเทคนิคโกลวดิสชาร์จสามารถทำได้ เช่นเดียวกับเทคนิคทางอิมิสชันอื่นๆ กล่าวคือ ธาตุที่สนใจจะถูกวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบการตอบสนองของธาตุนั้นกับความเข้มของแสงจากสารมาตรฐาน การวิเคราะห์ทำโดยการสร้างกราฟมาตรฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของแสงจากธาตุที่ต้องการวิเคราะห์กับความเข้มข้นของธาตุนั้นที่มาจากสารมาตรฐาน การสร้างกราฟมาตรฐาน และการวิเคราะห์ของตัวอย่างควรมีวิธีการเตรียมตัวอย่างที่เหมือนกัน และสภาวะที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ที่เหมือนกันเพื่อให้มีความแม่นและความเที่ยงสูง ในปัจจุบันยังเป็นการยากที่จะหาชุดของสารมาตรฐานที่มีองค์ประกอบหลัก (matrix) เช่นเดียวกับตัวอย่างที่วิเคราะห์ ดังนั้น การสร้างกราฟมาตรฐานจึงทำโดยการใช้สารมาตรฐานที่มีความใกล้เคียงกัน เช่นชุดของเหล็กเจือต่ำ (low alloy steel)

ตัวอย่างของการประยุกต์ของโกลวดิสชาร์จอพทิกอลอ米สชัน สเปกโตรมิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบทางเคมี เช่น

- โลหะต่างๆ เช่น เหล็กเจือต่ำ อะลูมิเนียม ทองแดง

- ตัวอย่างที่เป็นผง เช่น ผงโลหะทองแดง ตัวอย่างสารประกอบออกไซด์



- แก้ว
- เซรามิก
- พอลิเมอร์

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อหาความหนา (Quantitative depth profiles)

เนื่องจาก การเข้าชนของ อาร์กอน ไอโอดินที่ผิวของตัวอย่าง มีผลทำให้อะตอมของธาตุที่เป็น องค์ประกอบในตัวอย่างหลุดออกมานา จำกัด กระบวนการนี้จะเกิดใน ระดับอะตอม ซึ่งสามารถมองว่า เมื่อเกิดการทำให้อะตอมหลุดออก จำกัด (sputtering) อะตอมในชั้น ของอะตอมหนึ่งๆ จะถูกขับออกมานา แบบชั้นต่อชั้น (layer-by-layer) เมื่อเวลาของการทำให้อะตอมหลุด ออกจากผิวผ่านไปชั้นของอะตอม จะหลุดออกมาย่างต่อเนื่อง ทำให้ เห็นการกัดกร่อนเข้าไปในเนื้อของ ตัวอย่างซึ่งความลึกจะขึ้นอยู่กับ สภาวะและเวลาที่ใช้การวิเคราะห์ ดังรูปที่ 6 ซึ่งแสดงถึงตัวอย่างที่ถูก เคลือบสามชั้น เมื่อเวลาของการ วิเคราะห์ผ่านไป ภาพของการ วิเคราะห์ทำให้เห็นว่าตัวอย่างถูก เคลือบสามชั้น ข้อมูลเหล่านี้ยัง

สามารถบอกถึงความหนาของการ เคลือบได้ด้วย อย่างไรก็ได้รูปที่ 6 แสดงถึงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เท่านั้น เนื่องจากเป็นการฟอกความ สัมพันธ์ระหว่างปริมาณความเข้ม แสงกับเวลา การทำให้การวิเคราะห์ นี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถทำได้โดยยึดหลักการเดียว กับการวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบ ทางเคมี ทั้งนี้เนื่องจากการบันธาตุที่ สนใจออกจากผิวของตัวอย่างจะ เป็นไปแบบชั้นต่อชั้นของอะตอม ดังนั้นการวิเคราะห์ที่ทุกๆ หน่วย ความลึกของเวลาที่ใช้ในการบันทึก ข้อมูล เช่นทุกๆ 1 วินาที ทำให้ สามารถทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สำหรับการหาความหนาได้ เมื่อ ประกอบกับข้อมูลความลึกจากการ วิเคราะห์และความเข้มชั้นของธาตุ ที่มาจากการกลุ่มของสารมาตรฐานจะ สามารถคำนวณและทำการplot เป็นความเข้มชั้นกับความลึก ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ หาความหนาได้

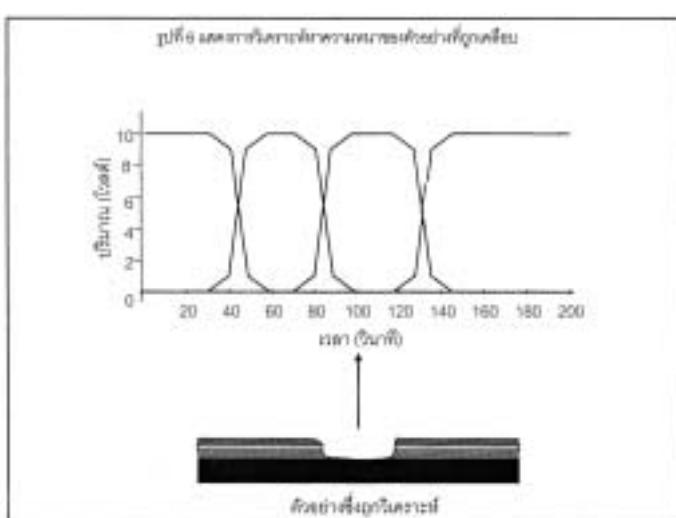
ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ โกลวิดิษาร์จอพทิคอลิมิสชันสเปกโตรมิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณเพื่อหาความหนา เท่านั้น

- การชูนเคลือบของโลหะ เช่น การชูนเคลือบของอะลูมิเนียม สังกะสี และซิลิคอนบนเหล็ก
- การหาความหนาของ ออกไซด์ฟิล์มนิวโลหะ เช่นเหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสม นิกเกิล
- การหาการสึกกร่อน เช่น การสึกกร่อนของเหล็ก และเหล็กกล้า ไร้สนิม
- การหาความหนาของการ เคลือบสำหรับเซมิคอนดัคเตอร์ และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ เช่น อะลูมิเนียมอาร์ดดิสก์ซึ่งอยู่ใน อาร์ดไดร์
- การศึกษาเกี่ยวกับการแพร่ ในโลหะผสมที่มีหลายชั้น

บทสรุป

โกลวิดิษาร์จอพทิคอลิมิสชันสเปกโตรมิเตอร์นับว่าเป็นเทคนิค ที่จะมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต ดังได้กล่าวมาแล้วว่าเทคโนโลยีหลักการ ที่ค่อนข้างง่าย สามารถใช้ในการ ตรวจสอบธาตุส่วนใหญ่ในตาราง ธาตุทั้งที่เป็นโลหะและไม่เป็นโลหะ ผลการวิเคราะห์ทดสอบมีความถูกต้อง แม่นยำสูง นอกจากนี้ยังสามารถ ประยุกต์ได้กว้างขวางทั้งในการวิเคราะห์ ทางเคมีและการวิเคราะห์พื้นผิว ทำให้โกลวิดิษาร์จอพทิคอลิมิสชันสเปกโตรมิเตอร์เป็นเทคนิคที่น่า สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิต วัสดุด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมการเคลือบสีรถยนต์ การผลิตอาร์ดดิสก์ และการผลิต เซมิคอนดัคเตอร์ ซึ่งจำเป็นต้อง





ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของชูบด้วยความหนาแน่นไม่โกรเมตลงไปถึงระดับนานาในเมตรสำหรับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในปัจจุบันสามารถให้บริการการวิเคราะห์ทางเคมีของโลหะ เช่น เหล็ก เหล็กกล้า ไรส์นิม และอะลูมิเนียมโดยสถาปัตยกรรมอิสาน เป็นโครงสร้าง

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการการ
หาความหนาของการเคลือบ/ชูบใน
ระดับไมโครเมตรด้วยกล้องจุลทรรศน์
(Optical microscope) หรือ
กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบ
สแกนนิ่ง (Scanning electron
microscope) ในอนาคตเพื่อเป็น
การเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการ

ให้สามารถรองรับงานที่ผลิตด้วย
เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีการเคลือบ/ชุบ
ด้วยความหนาระดับนาโนเมตร อาจ
จำเป็นต้องจัดหาเครื่องมือสำหรับ
การวิเคราะห์พื้นผิวเพิ่มขึ้น โกลวิดิส
ชาร์จออพทิกอลอ米สชันสเปกไทร-
เมตรีนบัวเป็นหนึ่งในบรรดาเทคนิค
เหล่านี้ที่น่าพิจารณา



ໂຄສາຣ້ວ່າງວິ

- Bengtson, A.; and Payling, R. **Glow discharge optical emission spectrometry**. Edited by R. Payling; D.G. Jones; and Bengtson. New York : Wiley, 1997, chap. 1. p.3-10, 20-44.

Bogaerts, A; and Gijbels, R. Fundamental aspects and applications of glow discharge spectrometric techniques (Review). **Spectrochimica Acta Part B**. 1998, vol. 53, p.1-42.

Luesaiwong, W. Application of radio frequency glow discharge optical emission spectrometry on bulk and depth resolved analysis of solid materials. **Ph.D. Dissertation Clemson University**, South Carolina : Clemson University, 2003. p.1-48.

Marcus, R.K. Radiofrequency powered glow discharges : opportunities and challenges. **Journal of Analytical Atomic Spectrometry**, September, 1996, vol. 11, p. 821-828.

การหาส่วน率ที่ดีที่สุดของวิธีวิเคราะห์ฯ (ต่อจากหน้า 35)

จากการทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่าง
ความเข้มข้นของอะลูมิเนียมไฮอ่อน และฟลูออโรไดท์
ไฮอ่อนของวิธีวิเคราะห์เชอร์โวติกเนียมด้วยเครื่องเฟลม
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโกรไฟโมโนเตอร์ โดยวิธี
simplex optimization พบว่าเมื่อทำการทดลองจำนวน
19 ครั้ง จะได้อัตราส่วนที่เหมาะสม คือ การทดลองที่ 17
ที่ความเข้มข้นของอะลูมิเนียมไฮอ่อนและฟลูออโรไดท์
ไฮอ่อนเท่ากับ 350 และ 810 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ

ทั้งนี้เนื่องจากการทดลองที่ 17 เป็นการทดลองที่ให้ค่าสูงสุดติดต่อกัน 3 ครั้ง จึงถือว่าการทดลองนี้เป็นการทดลองที่มีสภาวะที่ดีที่สุด

จะเห็นได้ว่าการนำเทคนิค simplex optimization มาใช้ในการหาสภาวะที่เหมาะสมของวิธีวิเคราะห์จะช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แล้วยังทำให้วิธีวิเคราะห์ที่ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย.

